

SANYO

三洋半導体ニュース

東京三洋電機(株)半導体(事)技術管理部
群馬県邑楽郡大泉町坂田180
郵便番号 370-05 電話 0276-63-2111 (大代表)

No. 327-4166

S1-A659NP

暫定規格

2SA659NP シリコンPNP三重拡散プレーナ型トランジスタ 低周波小信号増幅一般用

- あらゆる低周波小信号増幅回路一般に応用でき 2SC1175NP とコンプリメンタリ・ペアが組めます。
- 特に出力15Wまでの低周波電力増幅段の励振用に最適です。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

項 目	記 号	2SA659NP	単 位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-200	mA
コレクタ損失	P_C	400	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

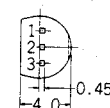
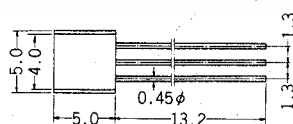
項 目	記 号	条 件	min.	typ.	max.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -40\text{V}, I_E = 0$			-10	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3\text{V}, I_C = 0$			-10	μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -5\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-50			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -50\text{mA}$	40	100	320	
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -10\text{mA}$		90		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}, I_B = -20\text{mA}$			-1.5	V

* 2SA659NP は 50mA h_{FE} によりつぎのように分類しています。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図

単位: mm



1. Base
2. Collector
3. Emitter

SANYO NP

